

## Второе извещение

Физико-Технический Институт  
имени А.Ф.Иоффе РАН,  
Физический факультет МГУ  
имени М.В.Ломоносова



**8-я Всероссийская Конференция  
«Нитриды галлия, индия и  
алюминия: структуры и приборы»  
Санкт-Петербург,  
26-28 мая 2011 г.**

<http://nitrides-conf.ioffe.ru>

**26-28 мая 2011 года** в Санкт-Петербурге, в Физико-Техническом Институте им. А.Ф.Иоффе РАН, состоится **8-я Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы»**.

Предыдущие конференции этой серии проходили в 2001-10 гг. попеременно в Москве и Санкт-Петербурге. Им предшествовали четыре рабочих совещания (1997-2000).

Совещания и Конференции демонстрировали постоянно возрастающую активность в области III-N в России, и в Конференции 2010г. приняли участие более 200 человек, представлявших более чем 100 организаций. Было сделано 110 докладов, из них 48 устных.

Спонсорами Конференции 2010 г. были РФФИ, ГК «Российская Корпорация Нанотехнологий», ОАО «Российская Электроника», группа компаний «Нитридные кристаллы», Aixtron AG, Veeco Instruments Inc., LayTec GmbH, TDI Inc.- Oxford Instruments, ЗАО «Эпицентр», ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», ФГУП ГЗ «Пульсар», ЗАО «Научное и технологическое оборудование», компания «GaGroup».

Конференция будет проходить в форме устных и стендовых сессий. Официальный язык Конференции – русский. Доклады от зарубежных участников могут быть сделаны на английском языке. На Конференции будет организована выставка промышленных компаний.

## **ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ**

1. Технология материалов: рост объемных кристаллов и подложки для эпитаксиального роста.
2. Технология материалов: эпитаксиальные методы роста.
3. Оптические, электрические, магнитные и другие свойства материалов.
4. Квантово-размерные структуры на основе нитридов.
5. Постростовые технологии обработки нитридных материалов.
6. Электронные, фотоэлектрические и другие приборы на основе нитридов.
7. Светодиоды и лазеры на основе нитридов.
8. Специальная сессия "Энергосберегающее освещение на основе полупроводниковых технологий".

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАТЫ**

### ***Предварительная регистрация:***

Форма и правила заполнения приведены на сайте конференции, срок регистрации – до **14 марта 2011 г.**

### ***Тезисы докладов:***

Объем тезисов доклада - 2 страницы (для приглашенных докладов - 4 страницы). Правила форматирования и образцы размещены на сайте конференции. Срок представления тезисов – до **4 апреля 2011 г.**

В рамках Конференции, по завершению сессии «Энергосберегающее освещение на основе полупроводниковых технологий», планируется проведение «Круглого Стола» «Производство полупроводниковых систем освещения в России – объявленные ранее планы и реальное состояние». Несмотря на несомненный прогресс, качественных изменений в отрасли за последние 10 лет не произошло. Планируется обсуждение текущей ситуации и проблем, мешающих достижению реальных результатов.

К участию в «Круглом Столе» приглашаются представители финансирующих организаций, промышленности и прикладной науки.

#### **Финансовая поддержка участников:**

Оргкомитет обратился в РФФИ и к возможным спонсорам («Роснано», «Росэлектроника», AIXTRON, VEESCO, LayTec, «Светлана - Оптоэлектроника», «Научное и технологическое оборудование»).

Российские участники получают финансовую поддержку в зависимости от выделенных средств и сроков предварительной регистрации.

#### **Организационный взнос**

Размер оргвзноса - **2000 руб.**

**На сайте конференции будут размещаться текущие новости и объявления для участников. Просьба регулярно заходить на сайт.**

<http://nitrides-conf.ioffe.ru>

#### **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ**

##### *Председатель*

П.С. Копьев, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

##### *Зам. председателя*

А.Э. Юнович, МГУ им. М.В.Ломоносова

##### *Ученый секретарь*

В.В. Лундин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

##### *Ученый секретарь*

А.Н. Туркин, МГУ им. М.В.Ломоносова

Н.Н. Бакин, ОАО "НИИПП"

П.Ю. Боков, МГУ им. М.В.Ломоносова

В.Н. Данилин, ГУП "Пульсар"

Е.Е. Заварин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

П.В. Иванников, МГУ им. М.В.Ломоносова

Г.В. Иткинсон, ЗАО "Тетис"

А.Р. Ковш, «Оптоган»

В.Е. Кудряшов, ГК "Роснано"

А.Е. Николаев, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

В.П. Чалый, "Светлана-Рост"



#### **ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ**

##### *Председатель*

П.С. Копьев, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

##### *Зам. председателя*

А.Э. Юнович, МГУ им. М.В.Ломоносова

##### *Ученый секретарь*

А.В. Сахаров, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

А.А. Вилисов, ОАО "НИИПП"

С.В. Иванов, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

С.Ю. Карпов, "Софт-Импакт"

Л.М. Коган, НПЦ "Оптэл"

Е.В. Луценко, ИФ НАН Беларуси

В.В. Лундин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

Ю.Н. Макаров,

ООО "Нитридные кристаллы"

О.П. Пчеляков, ИФП СО РАН

В.Г. Сидоров, СПбГТУ

В.М. Устинов, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

А.Ф. Цацульников,

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

С.Ю. Шаповал, ИПТМ РАН